

RFT SAY30 – SAY32 – SAY40 - SAY42

Silizium- Planar- Dioden im Plastikgehäuse für Anwendungen in der Digital-, NF – und HF- Technik, vorzugsweise als mittelschneller und schneller Schalter in Logikschaltungen.

	SAY30	SAY32	SAY40	SAY42	
Grenzwerte					
bei $\vartheta_a \leq \vartheta_{max}$					
Sperrspannung	U_R	25V	25V	15V	15V
Scheitelsperrspannung	U_{RWM}	30V	30V	20V	20V
Durchlaßstrom	I_F	30mA	50mA	20mA	30mA
Scheiteldurchlaßstrom	I_{FWM}	60mA	100mA	40mA	60mA
Stoßdurchlaßstrom ($\leq 1s$, Pause $\geq 2min$)	I_{FSM}	150mA	250mA	100mA	150mA
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	125°C	125°C	125°C	125°C
Lagerungstemperatur	ϑ_{stg}	-55°C	-55°C	-55°C	-55°C
	ϑ_{stg}	125°C	125°C	125°C	125°C
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_a = 25^\circ C$	P_{tot}	150mW	150mW	150mW	150mW

Dynamische Kennwerte

bei $\vartheta_a = 25^\circ C$

Nullpunktkapazität

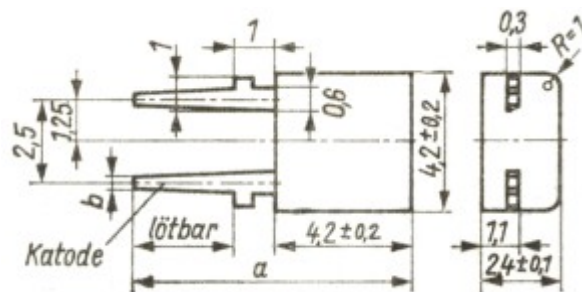
bei $U_R = 0V$, $f=0,5MHz$

Sperrerrholungszeit

C_0	$\leq 8pF$	$\leq 8pF$	$\leq 8pF$	$\leq 8pF$
t_{rr}	$\leq 65ns^{*)}$	$\leq 65ns^{*)}$	$\leq 10ns^{*)}$	$\leq 10ns^{*)}$

*) beim Schalten von $I_F = 10mA$ auf $U_R = 6V$,
gemessen bei $I_R = 1mA$; $R_L = 50 \Omega$

Bauform	a	b
L 2/4	8,2	0,55
L2/13	16,9	0,40



Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985